

(19) (KR)  
(12) (A)

(51) 。 Int. Cl.<sup>7</sup>  
H01L 23/50

(11)  
(43)

10-2004-0030298  
2004 04 09

(21) 10-2003-0064195  
(22) 2003 09 16

(30) 10/244,862 2002 09 17 (US)

(71) - 77070 , 249 20555

(72) 94402 46

94061 2295

94306 # 4276

(74)

:

(54)

(110)

가

(140)

PIRM

1

1

가

2

UV

가

, 가

3 UV 가 ,가  
 ,  
 4 3 , ,  
 5 ( ) 3 ,  
 6 ( ) ,  
 가 3 ,  
 7 가 3 , 1 ( ) 2  
 8 1 3 .  
 2

---

110 : 120 :  
 140 : 가 350 :  
 410 : 1 420 :

가  
 (mass produced cross point memory arrays)  
 (spun on)  
 (rigid wafer)  
 PIRM(Permanent Inexpensive Rugged Memory)  
 ( , MP3 ), / (PDA),  
 / 가 (MB)  
 , (1) 10 MB 1 가 (GB)  
 , (2) ( , <<1 ), (3)  
 (rugged physical characteristics) 가 , (4)  
 ( 1/1000 ) ( , 20 Mb/s) 가 ,  
 PCMCIA FLASH ,  
 storage) 'PIRM'(Portable Inexpensive Rugged Memory) (archival s



가

가

UV UN 가  
가  
(terminating pad)

( PIRM )

PIRM

가

3 , PIRM

09/875,356(

10002367)

가 PIRM  
09/875,833(

100034777)

10/245,897(

10000831

PIRM  
2; ' 가

) PIRM

가

가

1 ( 1)

1 2 1

( ) (140)  
가

(130)

가 )  
0.01 mm 0.05 mm

(140)

가 가 (

(130)

가 가

가 /I-A-Si/P+

/I-A-Si/N+

(120) 가 (130) 가

가 UV 가  
(120) (130)

UV 가 Tg  
가

가 , UV 가 (100) (120) (deform pressure) 2 1 (nib) (topological features) (110) PDMS(poly dimethyl siloxane) (120) UV (110) (110) (110) (110)가 (120) (120) (cleanly withdraw) (110) 가 (120) UV 가 (120) (120) (110)가 (120) (120) 3 (120) (350) (350) (crenellated) 가 (130) (120) (t (350) 3:1 (350) 가 (130) 3 5 (120) 가 (disparity) (12 0) ( ) (350) (130) 4 (5 (primary patterned films)(410) (transfer polymer)(510) (420) (420) 6 (610) (410) (420)( (transpose), (410) 가 2 2 1 2 1 2 ( 7). (structuring) 8 가 2 가



4. 1 ,

5. 1 ,

1 2 1 ,

6. 1 ,

UV 가 UV

7. 2 ,

8.

1 2 가 , 가 , 1 2

9. 8 ,

1 2 가

10. 8 9 ,  
가

1 2 UV







